

**RAPORT DE DOCUMENTARE**

**I. Datele de identificare a cererii**

(21) Nr. depozit: a 2018 0044  
 (22) Data depozit: 2017.11.16  
 (67) Numărul cererii transformate și data transformării: s 2017 0118; 2018.06.13  
 (71) Solicitant: **INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII "D. Ghițu", MD**  
 (54) **Titlul: Procedee de obținere a semiconductorilor pe bază de GaN:Mg**

**II. Clasificarea obiectului invenției:**

(51) **Int.Cl:** **C30B 7/10** (2006.01)  
           **C30B 25/02** (2006.01)  
           **C30B 29/38** (2006.01)  
           **B82B 3/00** (2006.01)

**III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)**

**MD - Intern « Documentare Invenții »** (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): C30B, Rusu, Ursaki, gan, mg, galiu, magneziu, hidroterm, autoclav

**"Worldwide" (Espacenet):** EN\_CL:GaN AND EN\_CL:nano\* AND EN\_CL:Mg,  
 EN\_CL:GaN AND EN\_CL:autoclav\*, gallium nitride, autoclave, magnesium nanoparticles,  
 Mg(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>-4H<sub>2</sub>O

**SU, EA, CIS (Eapatis):** (C30B\*\IC) AND (галли\*\KW) AND (магни\*\KW), (C30B\*\IC) AND (ацетат\*\KW) AND (галли\*\KW) AND (магни\*\KW), Mg(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>-4H<sub>2</sub>O

Alte BD – Mg(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>-4H<sub>2</sub>O, Rusu, Ursaki

**IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate**

[www.google.ru](http://www.google.ru)

**V. Documente considerate a fi relevante**

Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	Y. ChenN. JyotiJaehwan Kim. Strong deep-UV and visible luminescence from GaN nanoparticles, Applied Physics A, March 2011, Volume 102, Issue 3, pp 517-519	1-3
A, D, C	Li, Hui-Li & Xie, Rong-Jun & Hirosaki, Naoto & Dierre,	1-3

	Benjamin & Sekiguchi, Takashi & Yajima, Yoshiyoki. Preparation and Cathodoluminescence of Mg-Doped and Zn-Doped GaN Powders. Journal of the American Ceramic Society 91(5), 1711 - 1714, March 2008	
A	Rusu, Emil & Ursaki, Veaceslav & Simion, Raevschi & Vlazan, P. Preparation and characterization of Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> and GaN nanoparticles. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9258 · February 2015	1
<b>* categoriile speciale ale documentelor citate:</b>		
<b>A</b> – document care definește stadiul anterior general	<b>T</b> – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
<b>X</b> – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	<b>E</b> – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	
<b>Y</b> – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	<b>D</b> – document menționat în descrierea cererii de brevet	
<b>O</b> - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	<b>C</b> – document considerat ca cea mai apropiată soluție	
	<b>&amp;</b> – document, care face parte din aceeași familie de brevete	
<b>P</b> - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	<b>L</b> – document citat cu alte scopuri	
Data finalizării documentării 2018.10.23		
Examinator GHIȚU Irina jr.		